

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2000-260991
(P2000-260991A)

(43) 公開日 平成12年9月22日 (2000.9.22)

(51) Int.Cl.⁷
H01L 29/786

識別記号

F I
H01L 29/78

テームト(参考)

617N 5F110
613A
626C

審査請求 有 請求項の数 8 OL (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願平11-58958

(22) 出願日 平成11年3月5日 (1999.3.5)

特許法第30条第1項適用申請有り 1998年9月7日～9月10日 THE JAPAN SOCIETY OF APPLIED PHYSICS主催の「Extended Abstracts of the 1998 International Conference on SOLID STATE DEVICES AND MATERIALS」において文書をもって発表

(71) 出願人 391012327

東京大学長

東京都文京区本郷7丁目3番1号

(72) 発明者 平本 俊郎

神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷1-5-1-605

(72) 発明者 高宮 真

東京都足立区千住4-14-9 グリーンファンタジア 211号

(74) 代理人 100059258

弁理士 杉村 暁秀 (外8名)

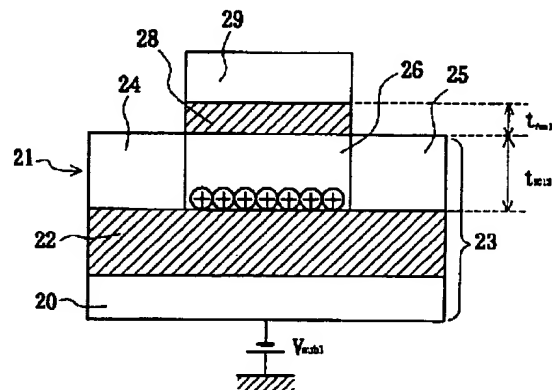
Fターム(参考) 5F110 AA01 AA05 AA08 AA09 BB04
DD22 EE10 EE30 FF02 GG02
GG12 GG25 GG34 GG37 QQ12

(54) 【発明の名称】 しきい値電圧を制御するMOSトランジスタを有する回路及びしきい値電圧制御方法

(57) 【要約】

【課題】 しきい値電圧を制御するMOSトランジスタの高速性及び消費電力の低減を両立させる。

【解決手段】 基板20に電圧 V_{sub1} が印加されると、ボディ26の絶縁層22に対する接合面付近にホールが誘起されたEIB-MOSトランジスタ構造となる。このように接合面付近にホールが存在することによって、空乏層深さが単結晶層21の厚さ t_{sc1} に相当することとなる。これによって基板バイアス効果が増大し、しきい値電圧を低下させたまま基板バイアス定数を増大させることができる。そのような効果は、EIB-DTMOトランジスタ構造にするとともにアキュムレーションモードで動作させた場合、顕著になる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 しきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを具え、そのMOSTランジスタが、半導体材料によって構成された基板、半導体材料によって構成された単結晶層及びこれら基板と単結晶層との間に介在する絶縁層を有するSOIを有し、前記単結晶層に、ソース領域と、ドレイン領域と、これらソース領域とドレイン領域とによって包囲された包囲領域とが形成され、その包囲領域の空乏層が前記絶縁層に達し、前記MOSTランジスタを、前記基板に第1の極性の電圧を印加することによって、前記包囲領域の前記絶縁層に対する接合面付近に第2の極性の電荷を誘起させたEIB-MOSTランジスタとしたことを特徴とするしきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを有する回路。

【請求項2】 前記EIB-MOSTランジスタを、DTMOS技術を用いて構成したEIB-DTMOSTランジスタとしたことを特徴とする請求項1記載のしきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを有する回路。

【請求項3】 前記EIB-DTMOSTランジスタを、チャネルに誘起されるキャリアと同一の導電型となるようにチャネルを不純物ドーピングしたアキュムレーションモードDTMOSTランジスタとしたことを特徴とする請求項2記載のしきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを有する回路。

【請求項4】 前記EIB-MOSTランジスタによってCMOS回路を構成したことを特徴とする請求項1から3のうちのいずれか1項に記載のしきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを有する回路。

【請求項5】 しきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを具え、そのMOSTランジスタが、半導体材料によって構成された基板、半導体材料によって構成された単結晶層及びこれら基板と単結晶層との間に介在する絶縁層を有するSOIを有し、前記単結晶層に、ソース領域と、ドレイン領域と、これらソース領域とドレイン領域とによって包囲された包囲領域とが形成され、その包囲領域の空乏層が前記絶縁層に達し、前記MOSTランジスタを、前記基板に第1の極性の電圧を印加し、前記包囲領域の前記絶縁層に対する接合面付近に第2の極性の電荷を誘起させたEIB-MOSTランジスタとしたことを特徴とするしきい値電圧制御方法。

【請求項6】 前記EIB-MOSTランジスタを、DTMOS技術を用いて構成したEIB-DTMOSTランジスタとしたことを特徴とする請求項5記載のしきい値電圧制御方法。

【請求項7】 前記EIB-MOSTランジスタを、チャネルに誘起されるキャリアと同一の導電型となるようにチャネルを不純物ドーピングしたアキュムレーションモードEIB-DTMOSTランジスタとしたことを特徴とする請求項5記載のしきい値電圧制御方法。

【請求項8】 前記EIB-MOSTランジスタによ

てCMOS回路を構成したことを特徴とする請求項7記載のしきい値電圧制御方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、大規模半導体集積回路(VLSI)を構成するしきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを有する回路及びそれに含まれるしきい値電圧制御方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】現在のVLSIの消費電力は増大の一途をたどっている。最近では、携帯端末用途など電池駆動のVLSIも多くなっており、高速性を維持しながら消費電力を大幅に低減させることが急務になっている。

【0003】VLSIを構成する金属-酸化膜-半導体(MOS)トランジスタにおいて、高速性及び消費電力に関連する最も重要なパラメータは、そのしきい値電圧である。高速性を実現するためにはしきい値電圧を低下させる必要があるが、しきい値電圧が低いとMOSTランジスタオフ時のリーク電流が増大し、その結果、MOSTランジスタの消費電力が増大する。

【0004】通常、しきい値電圧はMOSTランジスタのオン時・オフ時を通じてほぼ一定であるが、MOSTランジスタの基板部分の電圧を変更することによってしきい値電圧を制御することができる。すなわち、しきい値電圧の変化値 ΔV_{th} は、基板部分の電圧を V_{bs} とすると、

【0005】

$$\text{【数1】 } \Delta V_{th} = -\gamma V_{bs}$$

で与えられる。ここで、 γ は基板バイアス定数と呼ばれている。この結果、MOSTランジスタの高速性及び消費電力の低減を両立させる方法としては、MOSTランジスタの基板部分の電圧を変化させてMOSTランジスタのオン時のしきい値電圧を低下させるとともにオフ時のしきい値電圧を上昇させる方法を挙げることができる。

【0006】その具体的な方法として、VTMOS (Variable Threshold MOS) 技術及びDTMOS (Dynamic Threshold MOS) 技術が提案されている。

【0007】VTMOS技術を用いて構成されたVTMOSトランジスタでは、そのしきい値電圧を、VTMOSトランジスタが取り付けられたチップ全体で制御する。この場合、VTMOSトランジスタのオン時に基板部分に所定の電圧を印加するが、そのオフ時には、そのチップ全体で基板部分の電圧にオン時の電圧未満の電圧を印加して、しきい値電圧を上昇させている。

【0008】それに対して、DTMOS技術を用いて構成されたDTMOSトランジスタでは、図10に示すようなn型DTMOSトランジスタの場合、p型の半導体材料(例えば、シリコン)によって構成された基板1、

半導体材料（例えば、シリコン）によって構成された単結晶層2及びこれら基板1と単結晶層2との間に介在する絶縁層3（例えば、酸化シリコン層）を有するSOI 4を具え、単結晶層2には、n型のソース領域5と、n型のドレイン領域6と、これらソース領域5とドレイン領域6とによって包囲されたp型のボディ7とが形成され、ボディ7上にゲート酸化膜8を介して配置されたゲート電極9を、ワイヤ10を介してボディ7と電気的に接続して、そのしきい値電圧を制御する。すなわち、各DTMOSTランジスタのオン時にはそのしきい値電圧が常に低下し、オフ時にはしきい値電圧が常に上昇する。

【0009】DTMOSTランジスタ及び通常のMOSTランジスタのゲート特性を、横軸にゲート電圧 V_{gs} をとるとともに縦軸にドレイン電流 I_{ds} をとった図11のグラフを参照して説明する。 $V_{bs}=0$ に相当する曲線が通常のMOSTランジスタである。DTMOSTランジスタの場合、オン時はゲート電圧 V_{gs} が基板部分の電圧 V_{bs} に等しいので、しきい値電圧が ΔV_{th} だけ低下する。オフ時のリーク電流が同一であるとする、DTM

OSランジスタは ΔV_{th} 分だけゲート駆動力が向上する。なお、図11の V_{dd} は電源電圧を表す。

【0010】このようにして、VTMOS技術とDTMOS技術のいずれを用いても、MOSTランジスタの高速性を維持しながら消費電力を低減させることになる。

【0011】

【発明が解決しようとする課題】〔数1〕を参照すると、しきい値電圧を効率的に制御するためには基板バイアス定数 γ を大きくすればよいことがわかる。しかしながら、一般的にはMOSTランジスタで基板バイアス定数を大きくするためには、MOSTランジスタの不純物濃度を上昇させる必要があるのでしきい値電圧それ自体も上昇し、その結果、MOSTランジスタの高速性が損なわれる。このような事情のために基板バイアス定数 γ の最適化がこれまで行われておらず、基板バイアス定数 γ の値は通常0.1~0.3程度となっている。

【0012】ここで、通常のMOSTランジスタ及び通常の完全空乏型のSOI MOSTランジスタの基板バイアス定数 γ を、図12及び13を参照して説明する。図12に示す通常のN型チャネルのMOSTランジスタの場合、ソース領域11及びドレイン領域12が形成された基板13はP型となり、通常のP型チャネルのMOSTランジスタの場合、基板13はN型となる。基板13とゲート電極14との間に介在するゲート酸化膜15の厚さを t_{fox1} とし、ゲート酸化膜15の直下に形成された空乏層深さを l_d とすると、基板バイアス定数 γ は、

【0013】

【数2】 $\gamma \approx 3 t_{fox1} / l_d$

となる。したがって、基板バイアス定数 γ を大きくする

ためには不純物イオン濃度を高くして空乏層深さを l_d を小さくする必要がある。しかしながら、既に説明したように不純物イオン濃度を高くするとしきい値電圧も高くなる。部分空乏型のSOI MOSTランジスタの場合も同様である。

【0014】一方、図13に示したような完全空乏型のSOI MOSTランジスタの場合、SOI 16の絶縁層18及び単結晶層17の厚さをそれぞれ t_{box} 及び t_{soi} とし、ゲート酸化膜19の厚さを t_{fox2} とすると、空乏層深さが $t_{box} + t_{soi}$ に相当し、基板バイアス定数 γ は、

【0015】

【数3】 $\gamma \approx 3 t_{fox2} / (3 t_{box} + t_{soi})$

となり、基板バイアス定数 γ が極めて小さい値になる。

【0016】近年、VTMOS技術やDTMOS技術の特徴を従来以上に活用するとともに高速性と消費電力の低減との両立を可能にするために、MOSTランジスタのしきい値電圧を低下させたまま基板バイアス値を増大させることができるようにすることが所望されているが、かかる不都合のためにこれらの両立は困難なものとなっている。。

【0017】本発明の目的は、更なる高速性及び消費電力の低減を可能にするしきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを有する回路及びしきい値電圧を制御方法を提供することである。

【0018】

【課題を解決するための手段】本発明によるしきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを有する回路は、しきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを具え、そのMOSTランジスタが、半導体材料によって構成された基板、半導体材料によって構成された単結晶層及びこれら基板と単結晶層との間に介在する絶縁層を有するSOIを有し、前記単結晶層に、ソース領域と、ドレイン領域と、これらソース領域とドレイン領域とによって包囲された包囲領域とが形成され、その包囲領域の空乏層が前記絶縁層に達し、前記MOSTランジスタを、前記基板に第1の極性の電圧を印加することによって、前記包囲領域の前記絶縁層に対する接合面付近に第2の極性の電荷を誘起させたEIB-MOSTランジスタとしたことを特徴とするものである。

【0019】本発明によるしきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを有する回路によれば、基板に第1の極性の電圧（すなわち、正電圧又は負電圧）を印加する。これによって、基板に第1の極性の電荷が誘起される（正電圧を印加した場合には、正の電荷すなわちホールが誘起され、負電圧を印加した場合には、負の電荷すなわち電子が誘起される。）。このように第1の極性の電荷が誘起されることによって、空乏層が絶縁層に達した包囲領域の絶縁層に対する接合面付近に第2の極性の電荷が誘起される（正電圧を印加した場合には、負の電

荷すなわち電子が誘起され、負電圧を印加した場合には、正の電荷すなわちホールが誘起される。))。

【0020】このように絶縁層に対する接合面付近に第2の極性の電荷が存在することによって、MOSTランジスタの空乏層深さが単結晶層の厚さに相当することになる。既に説明したように、基板バイアス定数は空乏層深さに反比例するので、従来の完全空乏型SOI MOSTランジスタのように空乏層深さが単結晶層の厚さと絶縁層の厚さとの和に相当する場合に比べて基板バイアス定数を大きくすることができる。したがって、本発明によるしきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを有する回路によれば、不純物濃度を高くすることなく基板バイアス定数を大きくすることができ、その結果、しきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを有する回路の更なる高速性及び消費電力の低減を可能にする。

【0021】本発明によるしきい値電圧制御方法は、しきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを具え、そのMOSTランジスタが、半導体材料によって構成された基板、半導体材料によって構成された単結晶層及びこれら基板と単結晶層との間に介在する絶縁層を有するSOIを有し、前記単結晶層に、ソース領域と、ドレイン領域と、これらソース領域とドレイン領域とによって包囲された包囲領域とが形成され、その包囲領域の空乏層が前記絶縁層に達し、前記MOSTランジスタを、前記基板に第1の極性の電圧を印加し、前記包囲領域の前記絶縁層に対する接合面付近に第2の極性の電荷を誘起させたEIB-MOSTランジスタとすることを特徴とするものである。

【0022】本発明によれば、MOSTランジスタの更なる高速性及び消費電力の低減を可能にする。

【0023】EIB-MOSTランジスタを、DTMOS技術を用いて構成したEIB-DTMOSTランジスタなどとしてことができ、好適には、チャネルに誘起されるキャリアと同一の導電型となるようにチャネルを不純物ドーピングしたアキュムレーションモードDTMOSTランジスタとする。また、EIB-MOSTランジスタによってCMOS (Complementary MOS) 回路を構成した場合にも本発明を適用することかできる。

【0024】

【発明の実施の形態】本発明によるしきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを有する回路及びしきい値電圧を制御方法の実施の形態を、図面を参照して詳細に説明する。なお、図面中のn、p等は、その領域の導電型を表すものとする。図1は、本発明によるしきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを有する回路の第1の実施の形態を示す図である。本実施の形態では、MOSTランジスタをn型のSOI MOSTランジスタとし、このSOI MOSTランジスタは、シリコンによって構成された基板20、単結晶シリコンによって構成

された単結晶層21及びこれら基板20と単結晶層21との間に介在するSiO₂によって構成された絶縁層22を有するSOI23を有する。

【0025】単結晶層21には、n型のソース領域24と、n型のドレイン領域25と、これらソース領域とドレイン領域とによって包囲された包囲領域としてのボディ26とが形成される。ボディ26の空乏層は絶縁層22に達する。また、ボディ26とゲート電極27との間にゲート電極28が介在する。

10 【0026】本実施の形態では、基板20に第1の極性の電圧として負の電圧V_{sub1}を印加する。このような電圧V_{sub1}を、しきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを有する回路の外部から印可し又はしきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを有する回路内部で生成して印加する。

【0027】本実施の形態の動作を説明する。基板20に電圧V_{sub1}が印加されると、基板20に電子が誘起される。このように電子が誘起されることによって、ボディ26の絶縁層22に対する接合面付近にホールが誘起される。すなわち、従来の完全空乏型SOIトランジスタには存在しなかったP型領域を、電圧V_{sub1}によって電気的にボディ26に設ける。このような構造のMOSTランジスタを、EIB (Electrically Induced Body) -MOSTランジスタと称する。

【0028】このように接合面付近にホールが存在することによって、空乏層深さが単結晶層21の厚さt_{SOI2}に相当することになる。したがって、ゲート酸化膜28の厚さをt_{fox3}とした場合、このSOI MOSTランジスタの基板バイアス定数γは、

【0029】

【数4】 $\gamma \approx 3 t_{fox3} / t_{SOI2}$

となり、基板バイアス定数γがボディ26の不純物濃度に依存しないこととなる。したがって、本実施の形態によれば、しきい値電圧に依存せずに基板バイアス定数γを設定することができ、しかも単結晶層21の厚さt_{SOI2}が薄くなるに従って基板バイアス定数γが増大することがわかる。その結果、しきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを有する回路の更なる高速性及び消費電力の低減を可能にする。

40 【0030】図2は、本発明によるしきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを有する回路の第2の実施の形態を示す図である。本実施の形態では、MOSTランジスタをn型のインバージョンモードDTMOSTランジスタ29とし、その基板には負の電圧V_{sub2}を印可する。本実施の形態も、上記実施の形態と同様の作用効果を有する。

50 【0031】図3は、本発明によるしきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを有する回路の第3の実施の形態を示す図である。本実施の形態では、MOSTラン

ジスタを、チャネルに誘起されるキャリアと同一の導電型（この場合、 n 型）となるようにチャネルを不純物ドーピングした n 型のアキュムレーションモードDTMOSトランジスタ30とし、その基板には負の電圧 V_{sub3} を印可する。本実施の形態では、後に説明するように、基板バイアス定数 γ を著しく増大させたまましきい値電圧が低下し、高速性及び消費電力の低減の両立に更に好適なものとなる。

【0032】図4は、本発明によるしきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを有する回路の第4の実施の形態を示す図である。本実施の形態では、 n 型及び p 型のインバーションモードDTMOSトランジスタによってCMOS回路31を構成し、その基板に負の電圧 V_{sub4} 及び正の電圧 V_{sub5} をそれぞれ印加する。本実施の形態も、上記実施の形態と同様の作用効果を有する。

【0033】図5は、本発明によるしきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを有する回路の第5の実施の形態を示す図である。本実施の形態では、 n 型及び p 型のアキュムレーションモードDTMOSトランジスタによってCMOS回路32を構成し、その基板に負の電圧 V_{sub6} 及び正の電圧 V_{sub7} をそれぞれ印加する。本実施の形態も、上記実施の形態と同様の作用効果を有する。

【0034】次に、EIB-DTMOSトランジスタ、完全空乏型SOI MOSTランジスタ及び基板部分の電圧が零のEIB-MOSTランジスタの特性を、図6及び7を用いて比較する。なお、いずれのトランジスタも、ゲート酸化膜、単結晶層及び絶縁層の厚さをそれぞれ10nm、40nm及び100nmとし、ボディ P 型（したがってインバーションモード）で不純物濃度を 10^{16} cm^{-3} とする。図6は、サブスレッショルド特性を示す図である。この場合、横軸にゲート電圧 V_{gs} をとるとともに縦軸にドレイン電流 I_{ds} をとる。曲線FDで示す完全空乏型SOI MOSTランジスタの場合、オン時の電流が大きい反面オフ時（ $V_{gs}=0$ ）のときのドレイン電流が非常に大きくなる。一方、曲線ETICで示す基板部分の電圧が零のEIB-MOSTランジスタの場合、オフ時の電流が低く抑制されているが、オン時の電流も小さく、高速性がないことがわかる。曲線EIB-DTMOSで示すEIB-DTMOSトランジスタの場合、しきい値電圧がオン時とオフ時でダイナミックに変化するために、オン時の電流は大きくなり、かつ、オフ時の電流が小さくなり、その結果、高速性と消費電力の低減とが両立される。

【0035】図7は、オン電流／オフ電流特性を示す図である。この場合、横軸にオン電流 I_{on} をとるとともに縦軸にオフ電流 I_{off} をとる。図からわかるように、EIB-DTMOSトランジスタの場合、オフ電流が小さくオン電流が大きいことがわかる。なお、この場合のEIB-DTMOSトランジスタの基板バイアス定数 γ は0.8であった。また、EIB-DTMOSトランジ

スタの他の特徴として、短チャネル効果に強いということも挙げることできる。

【0036】次に、従来のDTMOSトランジスタ及びEIB-DTMOSトランジスタの特性を、図8及び9を用いて比較する。図8は、しきい値電圧と基板バイアス係数との関係を示す図である。この場合、横軸に基板バイアス定数 γ をとるとともに縦軸にしきい値電圧 V_{th} をとる。また、従来のDTMOSトランジスタの変化を曲線Conv.で示し、インバーションモードのEIB-DTMOSトランジスタの変化を、Inv. EIBで示し、アキュムレーションモードのEIB-DTMOSトランジスタの特性をAcc. EIBで示す。図からわかるように、アキュムレーションモードのEIB-DTMOSトランジスタではしきい値電圧 V_{th} を低く維持したまま基板バイアス定数 γ を大きくできることがわかる。

【0037】図9は、オン電流／オフ電流特性を示す図である。この場合、横軸にオン電流 I_{on} をとるとともに縦軸にオフ電流 I_{off} をとる。図からわかるように、アキュムレーションモードのEIB-DTMOSトランジスタでは、高速性と高速性と消費電力の低減とが最も両立されていることがわかる。

【0038】本発明は、上記実施の形態に限定されるものではなく、幾多の変更及び変形が可能である。例えば、上記実施の形態については、 N 型のMOSTランジスタについて説明したが、 P 型のMOSTランジスタについても本発明によるしきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを有する回路及びしきい値電圧を制御方法を同様に適用することができる。しきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタとして、VTMOS技術を用いて構成したVTMOSトランジスタを用いることができる。また、他のしきい値電圧制御技術を用いて大きな基板バイアス定数を生かすこともできる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるしきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを有する回路の第1の実施の形態を示す図である。

【図2】本発明によるしきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを有する回路の第2の実施の形態を示す図である。

【図3】本発明によるしきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを有する回路の第3の実施の形態を示す図である。

【図4】本発明によるしきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを有する回路の第4の実施の形態を示す図である。

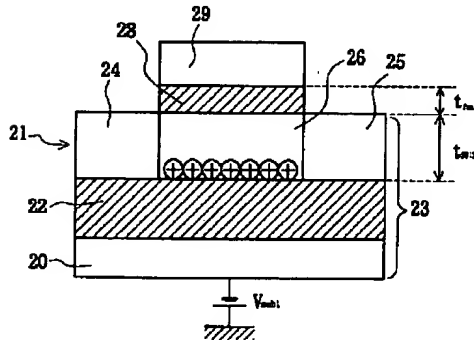
【図5】本発明によるしきい値電圧を制御しうるMOSTランジスタを有する回路の第5の実施の形態を示す図である。

【図6】サブスレッショルド特性を示す図である。

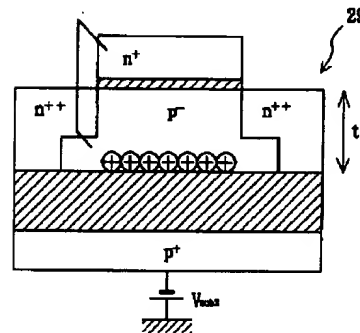
【図7】オン電流／オフ電流特性を示す図である。
 【図8】しきい値電圧と基板バイアス係数との関係を示す図である。
 【図9】オン電流／オフ電流特性を示す図である。
 【図10】従来のDTMOSTランジスタを示す図である。
 【図11】DTMOSTランジスタ及び通常のMOSTランジスタのゲート特性を示す図である。
 【図12】従来のMOSTランジスタを示す図である。
 【図13】従来のSOI MOSTランジスタを示す図である。
 【符号の説明】
 1, 13, 20 基板
 2, 17, 21 単結晶層
 3, 18, 22 絶縁層
 4, 16, 23 SOI
 5, 11, 24 ソース領域
 6, 12, 25 ドレイン領域
 7, 26 ボディ
 8, 15, 19, 28 ゲート酸化膜
 9, 14, 27 ゲート電極

10 ワイヤ
 29 インバージョンモードDTMOSTランジスタ
 30 アキュムレーションモードDTMOSTランジスタ
 31, 32 CMOS回路
 I_{ds} ドレイン電流
 l_d 空乏層の深さ
 t_{box} 絶縁層18の厚さ
 t_{fox1} ゲート酸化膜15の厚さ
 t_{fox2} ゲート酸化膜19の厚さ
 t_{fox3} ゲート酸化膜28の厚さ
 t_{SOI1} 単結晶層17の厚さ
 t_{SOI2} 単結晶層21の厚さ
 V_{bs} ボディ部分の電圧
 V_{dd} 電源電圧
 V_{gs} ゲート電圧
 $V_{sub1}, V_{sub2}, V_{sub3}, V_{sub4}, V_{sub5}, V_{sub6}, V_{sub7}$ 基板電圧
 V_{th} しきい値電圧
 ΔV_{th} しきい値電圧の変化分

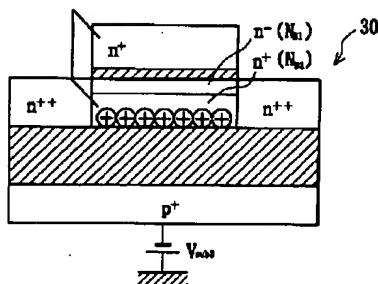
【図1】



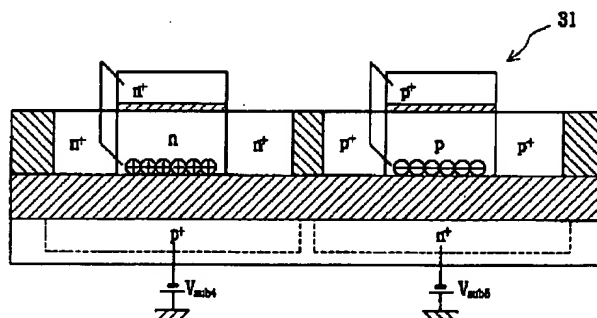
【図2】



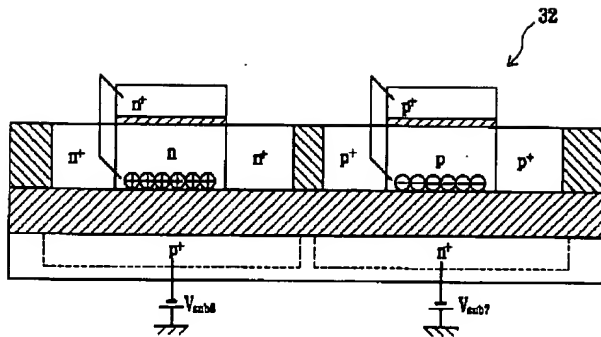
【図3】



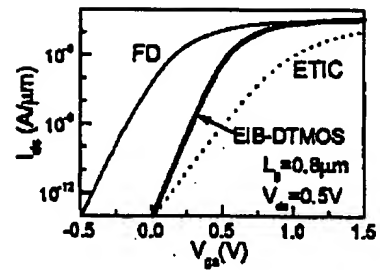
【図4】



【図5】

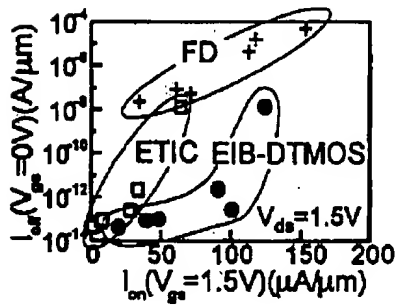


【図6】

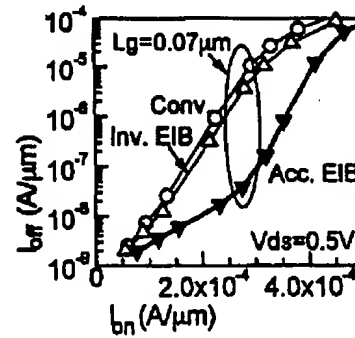
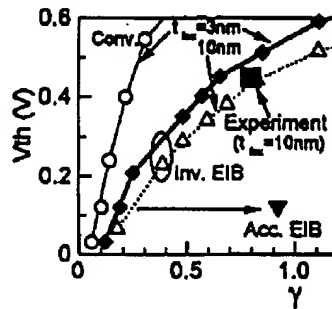


【図9】

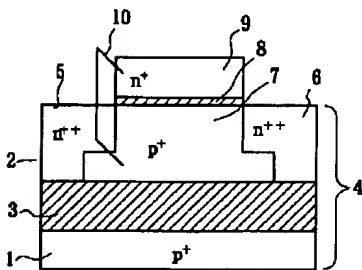
【図7】



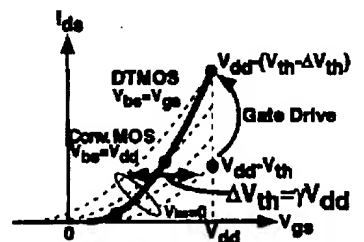
【図8】



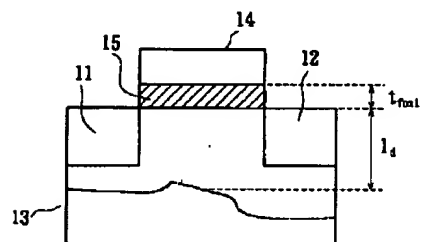
【図10】



【図11】



【図12】



【図13】

